

2SC1959M (3DG1959M)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

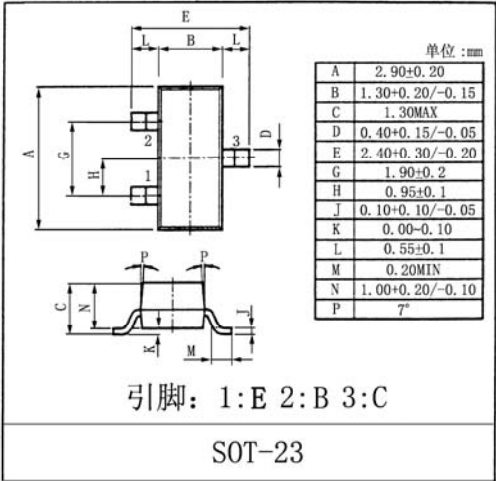
用途:用于音频小功率放大,激励级放大及开关电路。/Purpose: Audio frequency low power amplifier,driver stage amplifier and switching applications.

特征:极好的 h_{FE} 特性, 与 2SA562M(3CG562M) 互补。

Features: Excellent h_{FE} Linearity, complementary pair with 2SA562M(3CG562M).

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	35	V
V_{CE0}	30	V
V_{EB0}	5.0	V
I_C	500	mA
I_E	-500	mA
P_C	400	mW
T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
I_{CB0}	$V_{CB}=35V$	$I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=5.0V$	$I_C=0$			0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$	$I_C=100mA$	70		240	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=6.0V$	$I_C=400mA$	25			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA$	$I_B=10mA$		0.1	0.25	V
V_{BE}	$V_{CE}=1.0V$	$I_C=100mA$		0.8	1.0	V
f_T	$V_{CE}=6.0V$	$I_C=20mA$		300		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=6.0V$	$I_E=0$		7.0		pF

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications:

$h_{FE(1)}$ 分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	0	Y
$h_{FE(1)}$ 范围 $h_{FE(1)}$ Range	70~140	120~240
印章 Marking	HVBO	HVBY

